ЭЛЕКТРОДИНАМИКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

УДК 538.566.2;621.372.8

ПЛАЗМОННЫЕ РЕЗОНАНСЫ В ЗВЕЗДООБРАЗНОМ НАНОЦИЛИНДРЕ ИЗ ЗОЛОТА

© 2022 г. А. П. Анютин*

Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, пл. Введенского, 1, Фрязино Московской обл., 141190 Российская Федерация

**E-mail: anioutine@mail.ru* Поступила в редакцию 03.01.2020 г. После доработки 03.01.2020 г. Принята к публикации 27.02.2020 г.

Рассмотрена двумерная задача дифракции плоской электромагнитной волны *TM*-типа на цилиндрической 2D-наноструктуре из золота, контур поперечного сечения которой представляет собой звездообразную кривую. В световом диапазоне длин волн 400 нм < λ < 900 нм строгим численным методом рассчитаны спектры поперечника рассеяния и диаграммы рассеяния. Исследовано влияние потерь среды, геометрических размеров структуры на поперечник рассеяния и диаграмму рассеяния. Показано, что в области значений kD < 1 ($k = 2\pi/\lambda$, D – максимальный размер структуры, λ – длина волны) для такой структуры характерно существование одного резонанса у поперечника рассеяния и нескольких резонансов в спектре рассеяния. Показано также, что реальные потери золота делают невозможным наблюдение мультипольных резонансов у поперечника рассеяния. Обнаружен эффект вырождения плазмонов и ближнего поля структуры. Продемонстрировано влияние геометрических размеров структуры на поперечник рассеяния и спектр поглощения.

DOI: 10.31857/S0033849422010016

ВВЕДЕНИЕ

Дифракция электромагнитных волн на наноструктурах из благородных металлов (серебра, золота) в световом диапазоне длин волн 400 нм < $< \lambda < 900$ нм (при достоверность экспериментальных данных вызывает сомнения [1]) сопровождается образованием поверхностных волн (плазмон-поляритонов), а также сушествованием их резонансов. При этом резонансы плазмонов приводят к образованию резонансов поперечника рассеяния и поглощения на частотах, близких к резонансам плазмонов. Одним из важных свойств плазмон-поляритонов является высокая локализация электромагнитного поля вблизи поверхности наноструктур, что и определило интерес как к их исследованию, так и практическому использованию в субволновом и ближнепольном зондировании. В монографии [1] отмечалось, что наноструктуры в виде нанопровода из серебра и золота широко применяются в качестве сенсоров. Плазмонные резонансы в цилиндрических наноструктурах (нитях) с постоянной (переменной кривизной, но постоянным знаком кривизны) исследовались в целом ряде работ. В [1] показано, что цилиндры с круглым сечением реализуют резонансы плазмонов в ультрафиолетовой части

спектра. Используя нанотрубки, можно сместить частоты плазмонных резонансов в видимую область светового диапазона [2, 3]. Плазмонные резонансы в кварцевой нанонити, покрытой слоем золота переменной толщины в предположении, что границами оболочки являются круговые цилиндры со смещенными центрами, исследовались в [4]. Различные геометрии оболочек из серебра и кварца, контуры поперечного сечения которых образованы 2D-наноструктурами с различной формой поперечного сечения, анализировались в работах [5–9].

Цель данной работы — исследовать особенности плазмонных резонансов в 2D-наноструктуре из золота в случае, когда контур поперечного сечения структуры имеет звездообразную структуру. Из близких по тематике работ отметим [10, 11].

1. ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим двумерную задачу дифракции плоской поляризованной электромагнитной TMволны на двумерной цилиндрической диэлектрической наноструктуре, контур поперечного сечения которого представляет собой звездообразную структуру. Плоская волна распространяется в направлении единичного вектора ($\cos \varphi_0$, $\sin \varphi_0$, 0) и характеризуется в цилиндрической системе координат *r*, *φ* следующими компонентами электромагнитного поля:

$$H_z^0 = \exp[-ikr\cos(\varphi - \varphi_0)],$$

$$E_{\varphi}^0 = \eta\cos(\varphi - \varphi_0)\exp[-ikr\cos(\varphi - \varphi_0)], \quad (1)$$

$$E_r^0 = \eta\sin(\varphi - \varphi_0)\exp[-ikr\cos(\varphi - \varphi_0)].$$

Зависимость от времени выбрана в виде $\exp(i\omega t)$, где $\omega = kc$ — круговая частота, ($k = 2\pi/\lambda$ — волновое число свободного пространства, c — скорость света в вакууме, λ — длина волны), $\eta = 120\pi$ Ом — волновое сопротивление вакуума.

Контур поперечного сечения $r_S(\varphi)$ структуры в цилиндрической системе координат r, φ описывается формулой (см. рис. 1)

$$r_{\rm s}(\phi) = a + b\cos(6\phi). \tag{2}$$

Отметим, что, изменяя значение параметра *b*, можно изменять амплитуду колебаний "звездообразного" контура (2) рассеивающей наноструктуры. На рис. 1 изображен контур поперечного сечения структуры (2) при *a* = 40 нм, *b* = 25 нм и $\lambda = 625$ нм. Считается, что среда структуры представляет собой золото. При этом зависимость относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon_{Au}(\lambda) = \varepsilon' - i\varepsilon'' \equiv \text{Re}(\varepsilon_{Au}) - i \text{Im}(\varepsilon_{Au})$ золота от длины волны λ была рассчитана на основе интерполяции экспериментальных данных работы [12] кубическими сплайнами.

Пространственное распределение диэлектрической проницаемости для структуры, изображенной на рис. 1, имеет вид

$$\varepsilon(r, \varphi) = \begin{cases} \varepsilon_{Au}, & r < r_s(\varphi), \\ 1, & r > r_s(\varphi). \end{cases}$$
(3)

Исследование сформулированной задачи дифракции удобнее проводить, используя *z*-компоненту $U(r, \varphi) = H_z(r, \varphi)$ магнитного поля, так как краевая задача для функции $U(r, \varphi)$ является скалярной. Полное поле $U(r, \varphi)$, т.е. суперпозиция падающего и рассеянного полей, в кусочно-постоянной среде (3) удовлетворяет уравнению Гельмгольца

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + k^2 \varepsilon(r,\phi)\right]U(r,\phi) = 0.$$
(4)

Компоненты электрического поля могут быть выражены через функцию U(x, y)

$$E_{\varphi}(r,\varphi) = -\frac{\eta}{ik\epsilon(r,\varphi)} \frac{\partial U(r,\varphi)}{\partial r},$$

$$E_{r}(r,\varphi) = \frac{\eta}{ik\epsilon(r,\varphi)} \frac{\partial U(r,\varphi)}{\partial \varphi}.$$
(5)

РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА том 67 № 1 2022



Рис. 1. Геометрия задачи и контура поперечного сечения звездообразного рассеивателя (2) при a = 40 нм, b = 25 нм, $\lambda = 625$ нм.

На границах структуры должны быть непрерывны величины U и $\frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial U}{\partial N}$, где $\frac{\partial U}{\partial N}$ – производная по направлению нормали к границе раздела сред.

Как уже отмечалось, полное поле $U(r, \varphi)$ вне структуры состоит из падающего U^0 и рассеянно-го U^s полей:

$$U(r,\phi) = U^{0}(r,\phi) + U^{s}(r,\phi).$$
 (6)

Падающее поле задано функцией

$$U^{0} = \exp[-ikr\cos(\varphi - \varphi_{0})].$$
⁽⁷⁾

Рассеянное поле $U^{s}(r, \varphi)$ в цилиндрической системе координат (r, φ) , где $x = r \cos \varphi$ и $y = r \sin \varphi$, в дальней зоне $(kr \to \infty)$ должно удовлетворять условию излучения

$$U^{s} = \Phi(\varphi) \sqrt{\frac{2}{\pi k r}} \exp\left(-ikr + i\frac{\pi}{4}\right), \tag{8}$$

где $\Phi(\phi)$ – диаграмма рассеяния.

Полное сечение рассеяния σ_s и сечение поглощения σ_a определяется формулами

$$\sigma_s = \frac{2}{\pi k} \int_0^{2\pi} |\Phi(\varphi)|^2 d\varphi, \qquad (9)$$

$$\sigma_a = \frac{1}{k} \operatorname{Im} \oint \frac{\partial U}{\partial N} U^* ds.$$
 (10)



Рис. 2. Зависимость нормированных поперечника рассеяния (а) и сечения рассеяния (б) от длины волны λ для структуры с параметрами q = 6, a = 40 нм и различными b = 10 (1), 15 (2), 20 (3), 25 нм (4); угол падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/6$; потери золота – Im(ϵ).

2. ЧИСЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Численное решение сформулированной задачи проводили модифицированным методом дискретных источников [13, 14]. При этом точность решения задачи контролировали путем вычисления невязки δ граничных условий в линейной норме в точках, расположенных в середине между точками, где граничные условия выполняются точно (в таких точках граничные условия выполняются наихудшим образом [13]). Во всех приведенных ниже расчетах максимальная невязка граничных условий не превышает величину $\delta < 10^{-3}$.

На рис. 2а и 2б представлены соответственно результаты расчета нормированного поперечника рассеяния $k\sigma_s$ и нормированного сечения поглощения $k\sigma_a$ для различных значений длин волн λ и различных значений амплитуды 10 нм $\leq b \leq 25$ нм колебаний контура (2) структуры из реального золота. Угол падения плоской волны был равен $\phi_0 = \pi/6$. Из рис. 2а следует, что у такой рассеивающей структуры нормированный поперечник рассеяния $k\sigma_s$ имеет только один максимум, который смещается в сторону больших значений длин волн λ при увеличении амплитуды *b* колебаний контура (2). При этом, как видно из рис. 26, дополнительные максимумы у нормированного сечения поглощения $k\sigma_a$ появляются лишь при значениях *b* > 20 нм.

Было исследовано влияние потерь Im(є) на нормированный поперечник рассеяния $k\sigma_s$ и нормированное сечение поглощения $k\sigma_a$ для структуры, контур (2) которой имел следующие параметры q = 6, a = 40 нм, b = 25 нм, при угле падения плоской волны $\phi_0 = \pi/6$ (рис. 3а, 36). При расчетах мнимая часть $Im(\varepsilon)$ относительной диэлектрической проницаемости золота принимала следующие значения: $Im(\varepsilon)$, $0.5Im(\varepsilon)$ и $0.1 \, \text{Im}(\epsilon)$. Из результатов, представленных на рис. 3, следует, что реальные потери золота (кривая 1) приводят к исчезновению резонансов, связанных с мультипольными резонансами плазмонов(кривые 2, 3). Аналогичный эффект имеет место и для случая нормированного сечения поглощения $k\sigma_{a}$ (см. рис. 4) – резонансы, связанные с мультипольными резонансами плазмонов, здесь так же начинают проявляются лишь со значений 0.1 Im(є).

На рис. 4а, 4б представлены соответственно результаты расчета частотной зависимости нормированного поперечника рассеяния $k\sigma_s$ и нормированного сечения поглощения $k\sigma_a$ для структуры из реального золота и с увеличенными значениями параметров ее контура, по сравнения с рассмотренными выше случаями. Параметры контура (2) указаны в подрисуночной подписи. Угол падения плоской волны был равен $\phi_0 = \pi/6$. Из рис. 4а следует, что и при таких размерах рассеивающей структуры нормированный поперечник рассеяния $k\sigma_s$ имеет только один максимум при всех значениях длин волн λ из светового диапазона 400 нм $< \lambda < 900$ нм. Расположение максимума $k\sigma_s$ зависит от величины амплитуды b, определяющей колебания контура (2). Увеличение значений b приводит к смещению максимума $k\sigma_{s}$ в сторону больших значений λ .

Рисунки 5а, 5б иллюстрируют влияние потерь золота на результаты расчетов диаграмм рассея-



Рис. 3. Зависимость нормированного поперечника рассеяния (а) и сечения рассеяния (б) от длины волны λ для структуры с параметрами q = 6, a = 40 нм, b = 25 нм; угол падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/6$; кривая l – потери золота Im(ε), кривая 2 – потери золота 0.5 Im(ε), кривая 3 – потери золота 0.1 Im(ε).

ния $\Phi(\varphi)$ для структуры с параметрами a = 40 нм, b = 25 нм, угле падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/6$ и трех длин волн: $\lambda = 670$ (1), 600 (2), 510 нм (3). Данные, представленные на рис. 5а, соответствуют случаю отсутствия потерь золота Im(ε) = 0, а рис. 56 – 0.5 Im(ε). Из рисунков видно, что даже относительно малые потери золота существенно сказываются на форме диаграммы рассеяния.

Результаты расчетов пространственного распределения линий равных амплитуд поля H_z вблизи поверхности рассивателя (2) для трех длин волн : $\lambda = 670, 600$ и 510 нм представлены соответственно на рис. 6а–6в.



Рис. 4. Зависимость нормированных поперечника рассеяния (а) и сечения рассеяния (б) от длины волны λ для структуры с параметрами q = 6, a = 80 нм, b = 10 (*1*), 20 (*2*), 30 (*3*), 40 (*4*), 50 нм (*5*); угол падения плоской волны $\varphi_0 = \pi/6$; потери золота Im(ε).

Отметим, что для выбранных длин волн имеют место максимумы поперечника рассеяния (см. рис. 3). При этом параметры контура (2) характеризовались следующими значениями a = 40 нм, b = 25 нм; угол падения плоской волны был равен $\varphi_0 = \pi/6$; потери золота – 0.5 Im(ε). Из рис. 6а–6в видно, что вариации поля непосредственно вблизи границы рассивателя исчезают при удалении от нее точки наблюдения. Этот эффект свидетельствует о вырождении колебаний ближнего поля и объясняет двухлепестковую структуру диаграммы рассеяния рис. 56.



Рис. 5. Диаграмма рассеяния при $Im(\varepsilon) = 0$ (а) и при потерях золота $0.5Im(\varepsilon)$ (б) для структуры с параметрами a = 40 нм, b = 25 нм, $\varphi_0 = \pi/6$ на разной длине волны: $\lambda = 670$ (1), 600 (2), 510 нм (3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрена дифракция плоской волны на цилиндрической 2D-структуре, представляющей наноструктуру из золота, контур которой имеет звездообразную форму. Строгими численными методами рассчитаны спектральные и пространственные характеристики рассеянного поля. Показано, что для такой структуры характерно существование одного резонанса поперечника рассея-



Рис. 6. Пространственное распределение линий равных амплитуд модуля компоненты H_z поля структуры с параметрами a = 40 нм, b = 25 нм, $\phi_0 = \pi/6$, потери золота -0.5 Im(ε) и длине волны $\lambda = 670$ (a), 600 (б) и 510 нм (в).

ния и нескольких резонансов спектра рассеяния (последние связаны с существованием дипольных и квадрупольных резонансов плазмонов). Показано, что реальные потери золота делают невозможным наблюдение мультипольных резонансов у поперечника рассеяния. Обнаружен эффект вырождения в ближнем поле структуры. Продемонстрировано влияние геометрических размеров структуры на поперечник рассеяния и спектр поглощения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнена за счет частичного бюджетного финансирования в рамках государственного задания (тема 0030-2019-0014) и при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 19-02-00654).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Климов В.В.* Наноплазмоника. М.: Физматлит, 2009.
- Velichko E.A., Nosich A.I. // Opt. Lett. 2013. V. 38. № 23. P. 4978.

- 3. Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д. // РЭ. 2015. Т. 60. № 9. С. 896.
- 4. Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д. // РЭ. 2016. Т. 61. № 8. С. 757.
- 5. Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д. // РЭ. 2017. Т. 62. № 1. С. 35.
- 6. Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д. // Изв. вузов. Радиофизика. 2017. Т. 60. № 7. С. 600.
- 7. Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д. // РЭ. 2017. Т. 62. № 12. С. 1197.
- 8. Анютин А.П., Коршунов И.П. // РЭ. 2018. Т. 63. № 10. С. 1099.
- 9. Анютин А.П., Коршунов И.П., Шатров А.Д. // РЭ. 2018. Т. 63. № 5. С. 402.
- 10. *Giannini V., Sánchez-Gil J.A.* // J. Opt. Soc. Amer. A. 2007. V. 24. № 9. P. 2822.
- 11. *Nehl C.L., Liao H., Hafner J.H.* // Nano Lett. 2006. V. 6. № 4. P. 683.
- Johnson P.B., Christy R.W. // Phys. Rev. B. 1972. V. 6. № 12. P. 4370.
- Кюркчан А.Г., Минаев С.А., Соловейчик А.Л. // РЭ. 2001. Т. 46. № 6. С. 666.
- Anyutin A.P., Stasevich V.I. // J. Quantitative Spectroscopy and Radiation Transfer. 2006. V. 100. № 1–3. P. 16.